

Information



B 315 D, E, K
B 360 D, E, K

B 325 D, E, K
B 380 D, E, K

Internationale Vergleichstypen: Q2T 2227 TPQ 2222 Q2T 3725

Integrierte Transistorarrays mit 4 npn – Transistoren ohne und mit Kühlkörper

Vorläufige technische Daten

Besondere Merkmale: – erweiterter Spannungsbereich
– hohe Spannungsfestigkeit
– hohe Kollektorströme
– Integration unabhängiger, aber parametergleicher Transistoren
(ΔU_{BE} , Δh_{21E})

Gehäuse: DIL-Plast

Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26 713 für B 315 D, B 360 D, B 380 D
 21.2.1.3.16 nach TGL 26 713 für B 315 E, K, B 360 E, K, B 380 E, K
 21.1.1.3.16 nach TGL 26 713

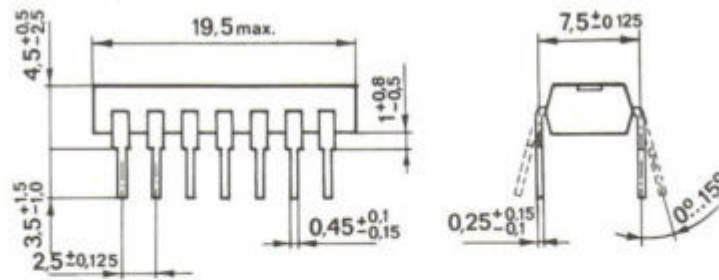
Masse: $\leq 1,5$ g; ≤ 15 g

Typstandard: TGL 42070

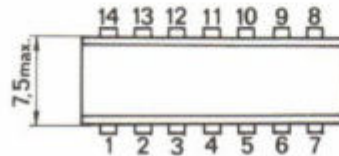
Abmessungen in mm und Anschlußbelegung:

B 315 D, B 325 D, B 360 D, B 380 D

1 – Kollektor T1	8 – Kollektor T3
2 – Basis T1	9 – Basis T3
3 – Emitter T1	10 – Emitter T3
4 – Substrat	11 – nicht belegt
5 – Emitter T2	12 – Emitter T4
6 – Basis T2	13 – Basis T4
7 – Kollektor T2	14 – Kollektor T4



21.2.1.2.14 TGL 26713

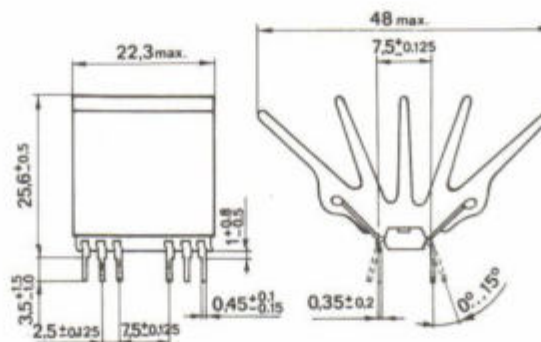


B 315 E, B 325 E, B360 E, B 380 E
B 315 K, B 325 K, B 360K, B 380 K

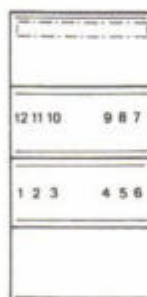
1 – Kollektor T1
2 – Basis T1
3 – Emitter T1
4 – –
5 – –
6 – Emitter T2
7 – Basis T2
8 – Kollektor T2

9 – Kollektor T3
10 – Basis T3
11 – Emitter T3 (Substrat)
12 – –
13 – –
14 – Emitter T4
15 – Basis T4
16 – Kollektor T4

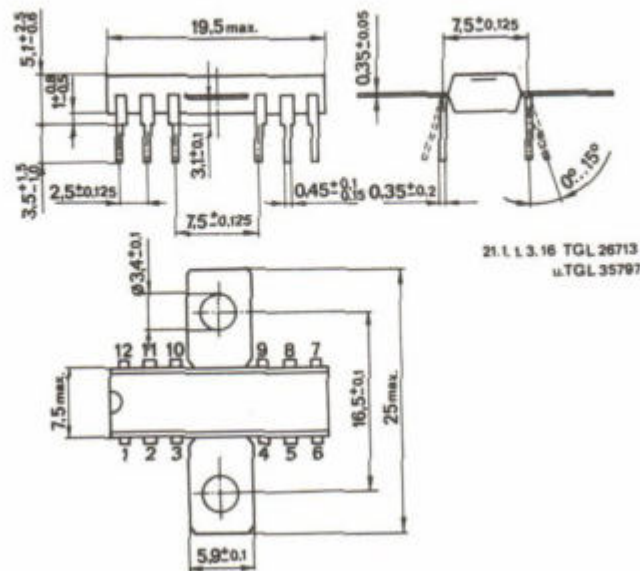
Anschluß 11 ist mit der Kühlfahne intern verbunden und liegt auf Substrat.
Der Substratanschluß muß immer auf das niedrigste Potential gelegt werden (gilt für alle Typen).



21.2.1.3.16 TGL 26713
u.TGL 35797



Typenzeichen



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich:

B 315 D,E,K B 325 D,E,K B 360 D,E,K B 380 D,E,K

		min.	max.	max.	max.	max.	
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}		15	25	60	80	V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}		20	30	90	100	V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}				5		V
Kollektorstrom	I_C				0,5		A
Impulsspitzenstrom	$\hat{I}_C$				1		A
Basisstrom	I_B				0,25		A
Gesamtverlustleistung	P_{tot}						
B 315 D B 360 D B 380 D					1,3		W
B 315 E B 360 E B 380 E					1,8		W
B 315 K B 360 K B 380 K					4		W
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-25	+85	+85	+85	+85	°C
Sperrschichttemperatur	ϑ_{jmax}				150		°C
Gesamtwärmewiderstand	R_{thja}						
B 315 D B 360 D B 380 D					85		K/W
B 315 E B 360 E B 380 E					65		K/W
B 315 K B 360 K B 380 K					30		K/W

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$):

		B 315 D,E,K	B 325 D,E,K	B 360 D,E,K	B 380 D,E,K
		min.	min.	min.	max.
Gleichstromverstärkung ¹⁾					
$U_{CB} = 2\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$		$h_{21E}(T1)$			
Gruppe B			28		71
Gruppe C			56		140
Gruppe D			112		280
Gruppe E			224		560
Kollektor-Basis-Reststrom		I_{CBO}			
$U_{CB} = 20\text{ V}$	B 315 D,E,K				100 nA
$U_{CB} = 30\text{ V}$	B 325 D,E,K				
$U_{CB} = 80\text{ V}$	B 360 D,E,K				
	B 380 D,E,K				
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung					
$I_C = 50\text{ mA}, I_B = 10\text{ mA}$		U_{CEsat}			
					0,5 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung					
$I_C = 1\text{ mA}$		$U_{(BR)CEO}$			
		15	20	60	80 V
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung					
$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$		$U_{(BR)CBO}$			
		20		90	100 V
Gleichstromverstärkungsgleichheit der Transistoren untereinander ²⁾					
$U_{CB} = 2\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$			0,8		1,25

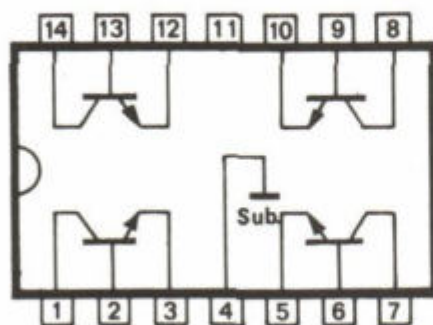
- 1) B 315 D,E,K – Vorzugsgruppe D
 B 325 D,E,K – Vorzugsgruppe D
 B 360 D,E,K – Vorzugsgruppe C
 B 380 D,E,K nur Gruppe B–D; Vorzugsgruppe C

2) nicht für B 380 D,E,K

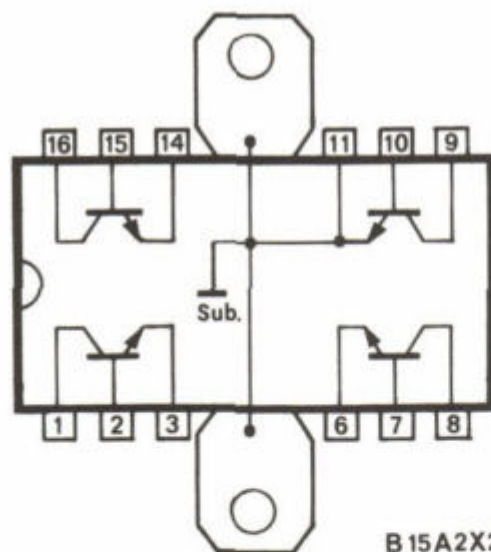
Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$):

		min.	max.
Übergangsfrequenz			
$U_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 15\text{ MHz}$	f_T	60	MHz

Innenschaltung:



B15A1X1



B15A2X2

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis B 315 D nach TGL 42 070

The logo consists of the letters 'RFT' in a stylized, blocky font. The letters are red with horizontal lines passing through them, giving it a technical or electronic appearance.

veb halbleiterwerk frankfurt/oder
leitbetrieb im veb kombinat mikroelektronik

elektronik
export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180
